



INSTITUTUL NATIONAL DE  
CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU  
OPTOELECTRONICA



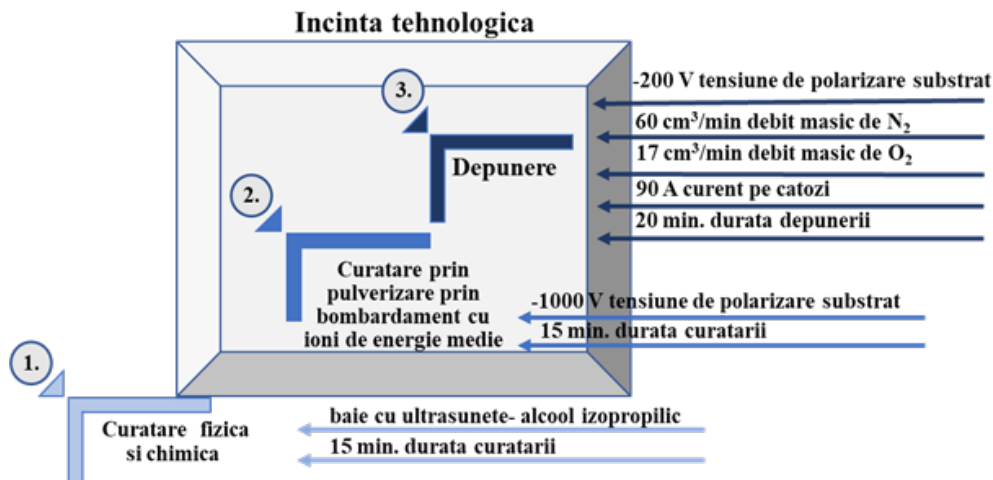
Certificat nr.: AJAEU/09/11337

Str. Atomistilor Nr.409, C.P. MG-5, Cod 077125, Magurele - Ilfov, Telefon/Fax: 021.457.45.22, E-mail:inoe@inoe.inoe.ro, http://inoe.inoe.ro

## FIȘĂ TEHNICĂ

"Tehnologie de obtinere structuri cu arhitectura multistrat pe baza de oxinitruri metalice nedopate si dopate cu Si"

<b>Domeniul de utilizare:</b> Materiale biocompatibile	
<b>Tip:</b> Tehnologie	<b>Brevete:</b>
<b>Status:</b> Nou	<b>Data:</b> 2023/06/14
<b>Proiectant:</b> INOE 2000 - Sisteme tehnologice bazate pe plasma si vid pentru noi materiale avansate nanostructurate	<b>Executant:</b> INOE 2000 - Sisteme tehnologice bazate pe plasma si vid pentru noi materiale avansate nanostructurate



**Date tehnice:** Definirea tehnologiei de laborator cuprinde pasii tehnologici utilizati pentru depunerea straturilor si operatiile specifice tehnologiei de depunere. Depunerea straturilor de nitrura si oxinitrura de Ti/TiSi cuprinde o etapa de pregatire a reperelor care trebuie acoperite (curatare fizica si chimica in exteriorul incintei tehnologice), precum si principalii parametri tehnologici asociati (presiunea reziduala in incinta de depunere, tensiunile de polarizare substrat in etapa de curatare prin bombardament ionic si in cea de depunere, temperatura substratului pe durata depunerii, intensitatea curentilor de alimentare a catozilor de Ti si TiSi, debitele masice de gaze de lucru (oxigen si azot) utilizate in depunerea nitrurilor si apoi a oxinitrurilor, durata tipica a procesului de depunere.